

# Análise de interface SiO<sub>2</sub>/Si através de espectro de XPS

Gonçalo G. Baptista<sup>1</sup>

<sup>1</sup> NOVA School of Science and Technology, NOVA SST, Portugal

Contacto / g.baptista@campus.fct.unl.pt

**Resumo** / Neste trabalho irá proceder-se à análise de um espectro de XPS adquirido a partir da irradiação de uma interface SiO<sub>2</sub>/Si com orientação (111) usando um feixe de fótons com energia de 130 eV, sendo neste caso estudadas as *binding energies* das orbitais 2p. Ao espectro obtido será realizado um fit que englobe as diferentes contribuições dos diversos estados de oxidação do Si e posteriormente a determinação da estequiometria e espessura de cada uma das camadas presentes.

**Abstract** / In this project, we will analyse a XPS spectrum acquired during the irradiation of a SiO<sub>2</sub>/Si (111) interface using an 130 eV X-Ray photon beam. This spectrum is related to the 2p orbitals' binding energies of multiple Si oxydated states which will be taken into account whilst performing fitting routines to the data that will then be used in the determination of the sample's stoichiometry and thickness.

**Keywords** / Espectroscopia XPS — SiO<sub>2</sub> — Estados de Oxidação

## 1. Introdução

Para a realização deste trabalho foi fornecido um espectro experimental de espectroscopia do tipo XPS\*, em que se irradiou uma amostra de Si (111) com fótons de 130 eV e se analisaram *core levels* do Si. Este espectro foi obtido através de um varrimento de energias com passos de 20 meV, permitindo analisar *binding energies* dos 96 aos 98 eV. Tal *range* corresponde às *binding energies* das orbitais 2p 3/2 e 2p 1/2 de diversos estados de oxidação do Si. Tais orbitais foram escolhidas devido ao facto de no SiO<sub>2</sub> ocorrerem 2 ligações duplas e sendo a configuração eletrónica do Si 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>2</sup>, os 4 eletrões menos ligados, ou seja, das orbitais 3p e 3s irão participar nas duas ligações duplas. Sendo assim, a orbital 2p será a orbital menos ligada do sistema no seu maior estado de oxidação.

## 2. Tratamento de Dados

Para todo o tratamento de dados recorreu-se à utilização de um *software* próprio para análise de espectros de XPS, o *CasaXPS*. Tal deve-se ao facto de possuir um inúmero conjunto de ferramentas de remoção de fundo e rotinas de *fitting* que serão uma mais valia na seguinte análise.

### 2.1. Remoção de Fundo

Para se proceder a um tratamento correto dos dados e à procedente interpretação de resultados, será de elevada importância remover o fundo presente no espectro. Tendo em conta o espectro obtido e a aparente forma do fundo, escolheu-se usar um *background* dos estilos *Tougaard*. Selecionou-se um *range* de energias de modo a

\*X-ray Photoelectron Spectroscopy

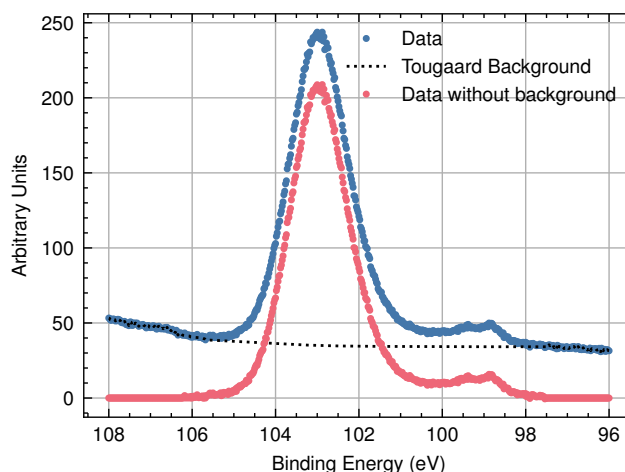


Figura 1: Dados com e sem Background removido

englobar os picos da 2p obtidos mas excluindo um pequeno pico presente em valores de *binding energy* mais altos devido a um plasmão. Na Fig. 1 pode encontrar-se o processo de remoção de fundo.

### 2.2. Desconvolução de picos

Observando-se a Fig. 1 rapidamente se identifica 1 pico bem definido\*\*. No entanto também se observa a presença de uma estrutura de forma irregular entre os 98 e os 100 eV. É necessário compreender, distinguir e quantificar as contribuições que os diferentes estados de oxidação do Si têm nestas estruturas. Considerou-se,

\*\*São, na realidade, vários picos convoluídos

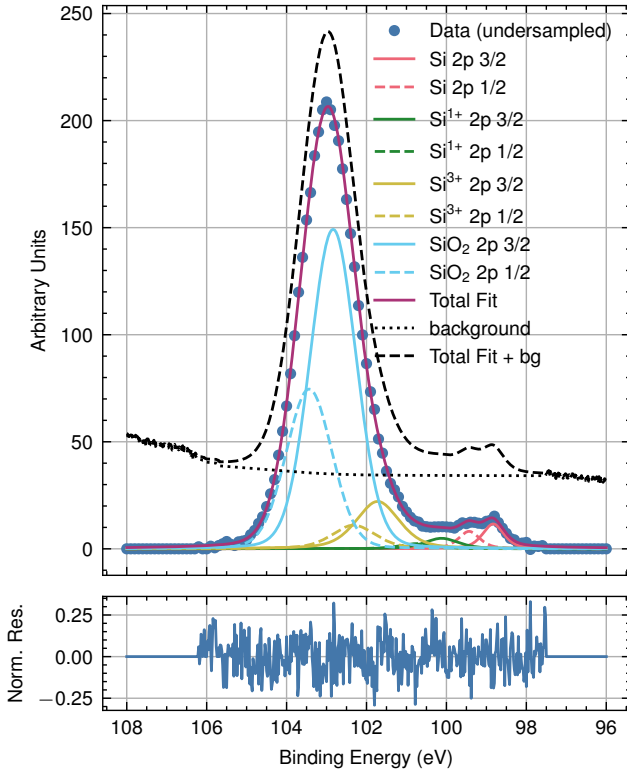


Figura 2: Componentes e Fit total

inicialmente a existência de Si em 5 estados diferentes: Si, Si<sup>1+</sup>, Si<sup>2+</sup>, Si<sup>3+</sup>, Si<sup>4+</sup>\*\*\*. Os valores de *binding energy* para os diferentes estados de oxidação foram inicialmente adaptados de [1], mas através de rotinas de *fitting*, encontraram-se os valores ótimos para este caso. Tendo em conta que as orbitais em estudo são do tipo p ( $l=1$ ) e que os eletrões possuem momento angular intrínseco ( $s=1/2$ ), irão existir **sempre** 2 tipos de acoplamento de momento angular possíveis ( $1 \pm 1/2$ ): 1/2 e 3/2. É possível também saber a razão entre a área dos picos para este acoplamento, devido ao número de estados de ocupação para cada um:

- p 1/2  $\rightarrow 2 \cdot 1/2 + 1 = 2$  eletrões
- p 3/2  $\rightarrow 2 \cdot 3/2 + 1 = 4$  eletrões

Logo, será de esperar que a intensidade dos picos referentes a 2p 3/2 seja o dobro dos referentes a 2p 1/2. Também é conhecido, para o Si que, por norma existe uma diferença de 0.6 eV entre os acoplamentos. Estes 2 factos referidos anteriormente foram usados como *constraints* aquando a realização dos *fits*.

Observou-se que, para além de quase todo o Si na interface se encontrar completamente oxidado (Si<sup>4+</sup>), ainda se encontra a presença de Si, Si<sup>1+</sup> e Si<sup>3+</sup>, notando-se a ausência de Si<sup>2+</sup>. Tendo em conta que as linhas possuem diferentes proporções de componentes Gaussianas e Lorentzianas, definiu-se que, a componente Gaussiana aumenta com a energia e fixou-se que os acoplamentos possuíam o mesmo tipo de linha e a mesma FWHM.

Os resultados obtidos (Tab. 1 e Fig. 2) fazem sentido visto que, a remoção de eletrões no processo de oxidação

\*\*\*Corresponde a SiO<sub>2</sub>

Tabela 1: Parâmetros do fit para as orbitais 2p 3/2 e comparação com valores de referência[2]. É possível calcular-se os parâmetros das orbitais 2p 1/2 somando 0.6 eV às Energias/centrodes e dividindo as intensidades por um fator de 2. Os restantes parâmetros são os mesmos. O tipo de linha usado representa uma *pseudo-voigt*, definida como a soma de uma Gaussiana com uma Lorentziana, neste caso com os mesmos parâmetros de média e desvio padrão, sendo o parâmetro usado o peso da parte Lorentziana. Ex:  $SGL(x) = (1 - 0.01 \cdot x)G + 0.01 \cdot x L$

State	Energy (eV)	En. Diff. (eV)	FWHM (eV)	Intensity (Arb. u.)	Line Type
Si	98.85		0.657	10.087	SGL(50)
Si <sup>1+</sup>	99.99		1.299	8.0485	SGL(40)
Si <sup>3+</sup>	101.77		1.329	37.911	SGL(30)
SiO <sub>2</sub>	102.84		1.341	221.6	SGL(10)

leva a uma menor energia de repulsão entre os restantes (sendo esta convencionalmente positiva), levando a um aumento da *binding energy* para estados mais oxidados. Também se observa que a FWHM, tal como a componente Gaussiana, aumentam com o estado de oxidação. Tal pode dever-se ao aumento da complexidade do sistema, devido à ligação entre os átomos. Também é de referir que os valores divergem ligeiramente de [1] devido a diferentes contribuições de Estado Sólido.

### 3. Quantificação

#### 3.1. Cálculo da estequiometria

Procedeu-se ao cálculo da estequiometria da interface com base numa simples aproximação mencionada em [1]. Serão calculados os pesos de cada uma das intensidades sendo necessário primeiro proceder à sua normalização com base nas secções eficazes de ionização. Resumidamente:

$$x_i = \left( \frac{I_i}{\sigma_i} \right) \cdot \left( \sum_i^n \frac{I_i}{\sigma_i} \right)^{-1} \quad (1)$$

Os valores de  $\sigma_i$  representam a secção eficaz de fotoionização da orbital 2p para o estado de oxidação  $i$  normalizada em relação à para o Si neutro e, para uma energia de feixe de 130 eV foram consultados em *TABLE II* de [1]. Tendo em conta a Eq. 1, é possível calcular-se agora a estequiometria do sistema. Esta será calculada (Tab. 2) para o sistema no seu total,  $x_i$  tot., (Si totalmente oxidado, os diferentes estados de oxidação e Si neutro) e para o sistema em estado de oxidação,  $x_i$  oxi., (totalmente oxidado e oxidações parciais). Tal deve-se ao facto de se considerarem 2 layers na amostra (uma superficial, contendo os estados de oxidação, e outra contendo Si puro). Mais uma vez esta análise apenas será realizada para os acoplamentos 2p 3/2 devido ao facto de o resultado ser o mesmo caso fossem considerados também os 2p 1/2, devido à *constraint* imposta aquando o processo de *fitting*, onde se forçaram estes a possuir metade da intensidade dos anteriores.

Tabela 2: Quantificao da presena de diferentes estados de oxidao na amostra

State	$I_i$	$\sigma_i$	$I_i/\sigma$	$x_i$ tot.	$x_i$ oxi.
Si	10.087	1	10.087	7.15%	—
Si <sup>1+</sup>	8.045	1.0	8.045	5.70%	6.14%
Si <sup>3+</sup>	37.911	1.7	22.300	15.80%	17.02%
SiO <sub>2</sub>	221.6	2.2	100.7	71.35%	76.84%

Conclui-se, tal como esperado, que a grande maioria da amostra se encontra totalmente oxidada e mais de 90% em pelo menos um estado de oxidao.

### 3.2. Determinao da espessura da amostra

Em [1]  refernciada a seguinte expresso que permite relacionar razo entre as intensidades,  $I$ , dos estados e mxima oxidao (SiO<sub>2</sub>) e oxidao nula (Si) com a *escape depth*,  $l$ , de tanto o Si como o SiO<sub>2</sub>, as seces eficazes de fotoionizao,  $\sigma$ , e a espessura da amostra,  $d$ :

$$\frac{I_{\text{SiO}_2}}{I_{\text{Si}}} = \frac{n_{\text{SiO}_2}}{n_{\text{Si}}} \frac{\sigma_{\text{SiO}_2}}{\sigma_{\text{Si}}} \frac{l_{\text{SiO}_2}}{l_{\text{Si}}} \cdot \left( \exp\left(\frac{d}{l_{\text{SiO}_2}}\right) - 1 \right) \quad (2)$$

O valor de  $\frac{I_{\text{SiO}_2}}{I_{\text{Si}}}$  foi obtido anteriormente atravs dos *fits* realizados, tendo um valor de 21.97, os valores do rcio das seces eficazes, da *escape depth* do Si e do SiO<sub>2</sub> para 130 eV foram, mais uma vez, retirados de [1] e possuem um valor de 2.2, 3.3  e 7.1 , respetivamente.

 possvel agora proceder-se ao clculo de  $d$ , deixando o rcio das densidades dos elementos como incgnita\*\*\*\*:

$$21.97 = \frac{n_{\text{SiO}_2}}{n_{\text{Si}}} \cdot 2.2 \cdot \frac{7.1}{3.3} \cdot \left( \exp\left(\frac{d}{7.1}\right) - 1 \right) \quad (3)$$

$$\exp\left(\frac{d}{7.1}\right) \approx 4.64 \cdot \frac{n_{\text{Si}}}{n_{\text{SiO}_2}} + 1 \quad (4)$$

$$d = 7.1 \cdot \ln\left(4.64 \cdot \frac{n_{\text{Si}}}{n_{\text{SiO}_2}} + 1\right) \quad (5)$$

## 4. Concluso

Tendo em conta todos os passos anteriores  possvel acordar-se que, de uma maneira geral, foi possvel caracterizar-se com algum detalhe a interface analisada. Embora o processo de *fitting* tenha sido algo complicado devido  alta convoluo e baixa intensidade dos picos para os estados de menor oxidao, foi possvel retirar-se resultados que aparentam alguma coeso e rigor com base na teoria e no esperado.

No que toca  quantificao dos resultado, foi possvel, de uma forma simplista calcular a estequiometria

\*\*\*\*Uma possvel aproximao seria usar o rcio dos valores calculados na estequiometria ao invs deste valor. Utilizando esta aproximao o valor de  $d$  seria 1.35 , bastante inferior ao esperado.

da amostra e, embora no tenha sido possvel obter-se um valor numrico para a espessura da amostra, foi possvel calcular-se uma aproximao para o clculo que a permite determinar.

*Agradecimentos:* Gostaria de agradecer  professora Ana Cristina Silva por sempre se ter mostrado disponvel aquando o esclarecimento de dvidas (e foram muitas) durante a realizao deste projeto.

## Referncias

- [1] F. Himpsel, F. McFeely, A. Taleb-Ibrahimi, Jory Yarmoff, and G. Hollinger. Microscopic structure of the sio2/si interface. *Physical Review B*, 38:6084–6084, 09 1988.
- [2] Nist x-ray photoelectron spectroscopy database, 2000.